

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-319920

(43) Date of publication of application: 10.11.1992

(51)Int.Cl.

G02F 1/136

G02F 1/133 G02F 1/1343

(21)Application number: 03-088088

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: NOMURA TAKAO

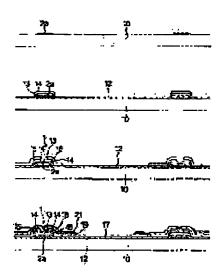
ADACHI MASAHIRO

(54) ACTIVE MATRIX LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent discrimination without narrowing an effective display section and improve the quality of a display.

CONSTITUTION: A guard electrode 21 is formed around a picture element electrode 17, so that the potential of the guard electrode 21 can be set to show a lateral component in the opposite direction of a lateral component in parallel to a glass board 10 which is caused by an electric line of force, passing through a liquid crystal layer, affected by the potential of a gate bus wiring. As a result, effect on an electric line of force taken by the potential of a signal line is cancelled by effect on an electric line of force of the potential of the guard electrode 21.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

◎ 016 グーツ

[Date of extinction of right]

b NEC-5091-&

(19) []本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-319920

(43)公開日 平成4年(1992)11月10日

(51) Int CL3		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G02F	1/136	5 O O	9018-2K		
	1/133	560	7820-2K		
	1/1343		9018-2K		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21) 出願番号	特顯平3-88088	(71) 出願人 000005049
		シャープ株式会社
(22) 出願日	平成3年(1991)4月19日	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72) 発明者 野村 孝夫
		大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ
		株式会社内
		(72)発明者 足立 昌浩
		大阪市阿倍野区長池町22番22分 シヤープ
		株式会社内
		(74)代理人 弁理士 山本 秀徽
	•	

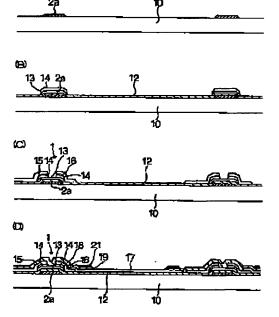
ω

(54) 【発明の名称】 アクテイプマトリクス液晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】有効表示部を狭くすることなく、ディスクリネーションの発生を防止して、表示品位を向上できるようにする。

【構成】絵素電極17の周囲にガード電極21が形成されており、そのガード電極21の電位を、液晶層を通る電気力線がゲートパス配線などの電位により影響を受けて生じるガラス基板10と平行な横方向成分と、逆方向の横方向成分が現れる電位に設定するようになっている。これにより、信号線電位から受ける電気力線への影響が、ガード電極21電位の電気力線へ及ぼす影響により打ち消される。



(2) 特謝平4-319920

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の絶縁性基板の間にプレティルト角を 定めて液晶層を設けたアクティブマトリクス液晶表示装 置において、該一対の基板のいずれか一方の基板内面に マトリクス状に配列された絵楽電極と、該絵楽電極に信 号を供給する信号線と、該絵素電板の周辺部に該絵素電 極と電気的に絶縁した状態で形成されたガード電極と、 を備え、該ガード電極に該液品層を通る電気力線が設信 号線の電位により受ける影響を打ち消す電位が与えられ る構成となしたアクティブマトリクス被乱表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、薄膜トランジスタ(以 下では「TFT」と称する)を用いたアクティブマトリ クス表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】上記アクティブマトリクス表示装置とし ては、従来、図? (断面図) に示すものが知られてい る。この表示整置は、アクティブマトリクス基板150 と対向基板160とを備えている。アクティブマトリク 20 ス基板150には、ガラス等からなる第1の絶縁性基板 101上に配したTFT102及び絵素電極103がマ トリクス状に設けられ、このTFT102に接続して走 査信号を供給するゲートバス配線114と映像信号を供 給するソースパス配線115が設けられている(図5参 服)。更には、図?に示すようにその上に全面にわたっ て形成した保護膜としてのパッシベーション膜(図示せ ず)と、その上に形成した通常ポリイミド膜からなる配 向膜104が設けられている。この配向膜104にはラ ピング法によって配向処理が施されている。

【0003】一方の対向基板160には、ガラス等から なる第2の絶縁性基板105上に、クロム膜をスパッタ リング法で成膜し、図6に斜線で示した形状にパターニ ングして開口部121を有する遮光膜120が形成され ている。この遮光膜120は上記アクティブマトリクス 基板150からの漏れ光を遮断する機能を果たし、関ロ 部121が有効表示部となる。 遮光膜120上には更 に、図7に示すように透明電極からなる対向電極106 がほぼ全面に形成され、対向電極106上には、配向処 理が施された配向膜107が形成されている。

【0004】そして、対向配置になしたアクティブマト リクス基板150及び対向基板160の間には、両基板 150、160の間隔を一定に保持するスペーサとして のプラスチックビーズ109が挟まれた状態で、液晶層 110がシール樹脂108によって封入されている。

【0005】このように構成したアクティブマトリクス 表示装置では、絵索電極108と対向電極106との間 に液晶層 110及び配向膜104、107が存在する。 これらによってコンデンサが形成され、絵素電極103

他方の包種をなす。この一方の意極をなす絵楽電極10 3には、図5に示すようにTFT102のドレイン電極 が接続され、TFT102のソース電板にはソースパス 配線115が接続されている。このソースパス配線11 5と前記ゲートパス配験114とは、それぞれシール樹 **脂108の外側で電板端子に接続されている。**

2

【0006】このアクティブマトリクス表示装置の駆動 は、例えば図5に示すようにして多数形成したゲートバ ス配線114のうち最上段のゲートパス配線114から 10 順次走査パルス信号を入力していき、ゲートパス配線1 14に接続されたそれぞれのTFT102をオン状態と し、この走査パルス信号に同期させてソースパス配線 1 15から映像信号を入力する。これにより、各絵赤電極 103と対向電板106とに電圧が印加され、液晶層1 10内の液晶分子の配向変化が起こり、アクティブマト リクス表示装置において表示が行われる。

【0007】さて、この表示動作の際、例えば前記被品 **暦110の誘電率異方性が正である場合、電圧を印加し** ないときは図8に示すように、被晶層110の被晶分子 130の分子軸は絵索電極103の表面に対してプレテ ィルト角θをもって配向している。このプレティスト角 θは、電圧印加時に液晶分子130の配向変化の方向を **同一にして、均質な表示を行うために設定されている。** 一方、電圧印加時には被晶分子130の分子軸は絵末電 極103の表面に対して略垂直に配向状態を変える。な お、上記誘電率異方性が負の場合には、液晶分子130 の分子軸の方向は、電圧が印加されたときと印加されな いときとで逆になるが、液晶分子130は同様に配向状 娘を変える。

30 [0008]

> 【発明が解決しようとする課題】ところで、上記の従来 装置においては絵素電板103と対向電極106との間 で電界が発生するが、その電界が輸業電板103の近傍 にあるソースパス配線115及びゲートパス配線114 の電圧により影響を受ける。これにより、図9に示すよ うに絵楽電極103の端部Aにおける電気力線132が 基板101と平行な方向の成分を有して湾曲した状態と なりやすい。このような状態になると、図10に示すよ うに絵楽電極103の媚部Aの上側に位置する被晶分子 130が、上記プレティルト角8の方向とは逆向きに配 向(リバースティルト)し、リパースティルトによるデ ィスクリネーションが発生する。そして、ディスクリネ ーションが発生した部分では、液晶分子130による光 制御が正常に行われず、よってディスクリネーション発 **生部が有効表示部内に位置する場合には、コントラスト** が低下するなどして表示品位が損なわれるという問題点 があった。

【0009】なお、有効表示部を狭くしてディスクリネ ーション発生部を覆うようにすれば、表示品位が損なわ が該コンデンサの一方の電極をなし、対向電極106が 50 れることを防止できるが、表示部が狭くなる難点があ (3)

特別平4-319920

వ.

【0010】本発明は、このような従来技術の問題点を 解決するものであり、有効表示部を狭くすることなく、 ディスクリネーションの発生を防止して、表示品位を向 上できるアクティブマトリクス表示装置を提供すること を目的とする。

3

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明にかかるアクティ プマトリクス被晶表示装置は、一対の絶縁性基板の間に プレティルト角を定めて液品層を設けたアクティブマト 10 リクス液晶表示装置において、該一対の基板のいずれか 一方の基板内面にマトリクス状に配列された絵素電極 と、敵檢索電極に信号を供給する信号線と、該檢索電極 の周辺部に該絵奏電極と電気的に絶縁した状態で形成さ れたガード電板と、を備え、該ガード電板に該液晶層を 通る電気力線が該信号線の電位により受ける影響を打ち 消す電位が与えられる構成となしてあり、そのことによ り上記目的が達成される。

[0012]

極が形成されており、そのガード電極の電位を、液晶層 を通る電気力線が信号線電位により影響を受けて生じる 基板と平行な横方向成分と、逆方向の横方向成分が現れ る電位に設定するようになっている。このため、信号線 電位から受ける電気力線への影響が、ガード電極電位の 電気力線へ及ばす影響により打ち消される。

[0013]

[実施例] 本発明の実施例について以下に説明する。

【0014】 図4は本発明のアクティブマトリクス液晶 表示装置を示す断面図である。この表示装置は、対向配 30 置したアクティブマトリクス基板30及び対向基板40 と、両基板30と40との間に設けた液晶層50とから なる。

【0015】上記アクティブマトリクス基板30は、図 1 (平面図) に示す構成となっている。このアクティブ マトリクス基板30は、次のようにして作製される。図 4に示したガラス基板10の上にスパッタリング法によ りTa金属港蹼を形成し、このTa金属蒋膜をフォトリ ソグラフィ法によりパターニングして、図2A(平面 図) 及び図3A (図2AのX-Xによる断面図) に示す 40 ようにゲートバス配線2及びゲートバス支線2aを形状 した。このゲートパス支線2 a の先端部は、後に形成さ れるTFT1 (図1参照) のゲート電極として機能す

【0016】次に、この基板10の上に全面にわたっ て、室化シリコン膜、ノンドープアモルファスシリコン 膜、n⁺型アモルファスシリコン膜を順次プラズマCV D法により形成する。その後、アモルファスシリコン 膜、及びπ+型アモルファスシリコン膜を同様にパター ニングし、図2B(平面図)及び図3B(図2BのX-50 2が接続されている。

Xによる断面図) に示すように、基板10の上にわたっ て空化シリコン膜からなるゲート絶縁膜12を形成する と共に、ゲートバス支線2aの先端部の上に、ノンドー プアモルファスシリコン膜からなる半導体層13と、n +型アモルファスシリコン膜からなるコンタクト度14 を形成した。

【0017】次に、この基板10上の全面にTi金属薄 膜を形成した後、この金属薄膜をバターニングして、図 2C (平面図) 及び図3C (図2CのX-Xによる断面 図) に示す形状のソース電極15、ドレイン電極16及 びソースパス配線20を形成した。このとき、前記コン タクト層14の中央部もエッチング除去し、ソース電極 15の下方の部分と、ドレイン電極16の下方の部分と に分割した。以上によりTFT1が完成する。

【0018】次に、この基板10上の全面に電化シリコ ン膜をプラズマCVD法によって形成し、パターニング を行って、図3D(図1のY-Y線による断面図)に示 すようにTFT1上に保護膜18を形成した。この保護 膜18はポリイミドでもよいが、この場合にはスピンナ 【作用】本発明にあっては、絵素電極の周囲にガード電 20 一でポリイミドを飽布し、焼成パターニングを行う。次 に、この基板10上の全面にITO膜を形成した後パタ ーニングを行って、図1に示すような形状の絵案電板1 7を形成し、更にその上の全面に図4(図1の2-2に よる断面図) に示すよう配向膜24を形成した。

> 【0019】次に、この基板10上の全面に室化シリコ ン膜をプラズマCVD法によって形成しパターニングを 行って、図3Dに示すように絵素電極17の周辺部に絶 録膜19を形成した。更に、この基板10上の全面にT i 金属薄膜を形成した後パターニングを行い、図1に示 す形状のガード電極21を形成した。これにより、アク ティブマトリクス基板30が完成する。

【0020】一方、上記アクティブマトリクス基板30 と組み合わせられる対向基板40は、図4に示すよう に、ガラス基板41上に透明な対向電極42が形成さ れ、更にその上にラビング処理の施された配向膜43が 形成されている。このラビング処理は、上述したアクテ ィブマトリクス基板30に設けた配向膜24にも施され ており、両基板30、10の間に封入される液晶層50 の被晶分子のプレティルト角を設定するために行ってい

【0021】このような対向基板40と上述したアクテ ィブマトリクス基板30とを、前述の従来例と同様にシ ール樹脂などを用いて貼合わせ、両基板30、40の間 に液体を封入して液晶層50を形成する。

【0022】これにより本発明のアクティブマトリクス 被品表示装置が完成される。なお、上記シール樹脂の外 側には、外部の制御回路と接続するための複数の電極端 子(図示せず)が設けられ、その電極端子に上述したガ ード電極21、ソースバス配線20及びゲートバス配線

(4)

特別平4-319920

5

【0023】このような構成のアクティブマトリクス液体表示装置において、例えば絵素電極17の電位が-6V、ゲートバス配線2の電位が-15V、対向電極42の電位が0Vのとき、ガード電極21の電位を0Vにすると、ゲート電極電位が液晶層中の電界に与える影響と、ガード電極21の電位が液晶層中の電界に与える影響とが打ち消し合い、図4に示すように電気力線60が基板に対してほぼ垂直な理想的な形に近くなる。これにより、有効表示部を狭くすることなくリパースティルトが発生するのを防止できる。

[0024]

【発明の効果】本発明による場合には、被晶分子のリパースティルトを防止できるので、ディスクリネーションの発生を防ぐことができ、これにより有効表示部を狭くすることなくコントラストが良好で、高い表示品位を有するアクティブマトリクス被暴表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のアクティブマトリクス液晶表示装置の一実施例に用いられるアクティブマトリクス募板の平面 20 図。

【図2】(A)、(B) 及び(C) はそれぞれ図1のアクティブマトリクス基板の製造工程を示す平面図。

【図3】 (A), (B), (C) 及び (D) はそれぞれ 同製造工程を示す断面図。

【図4】本発明のアクティブマトリクス液晶表示装置の 電気力線の方向を示す断面図。

【図 5】従来のアクティブマトリクス基板を示す平面 図。

【図6】従来の対向基板の平面図。

【図7】従来のアクティブマトリクス表示装置の断面 図。

10 【図8】従来のアクティブマトリクス状における液晶分子の配向方向を示す筋面図。

【図9】同電気力線の方向を示す断面図。

【図10】ディスクリネーションが有効表示部上に発生 した状態を示す断面図。

【符号の説明】

1 TFT 10、41 ガラス基板

17 絵案電板

21 ガード電極

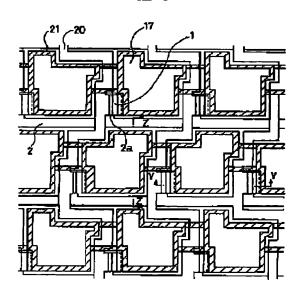
30 アクティブマトリクス基板

40 対向基板

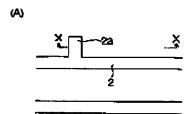
42 対向電極

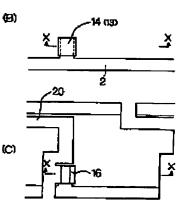
50 液晶層

[図1]



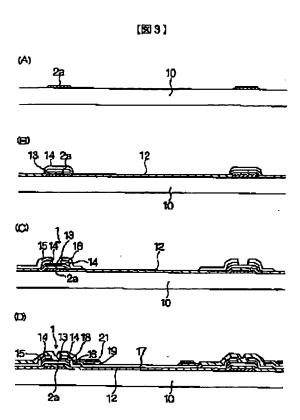
【図2】

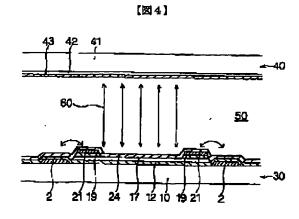


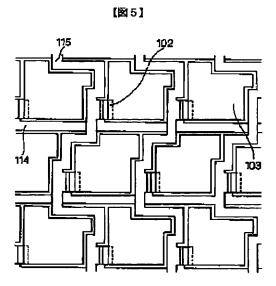


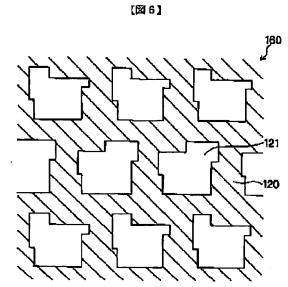
(5)

特朗平4-319920









(6)

特例平4-319920

